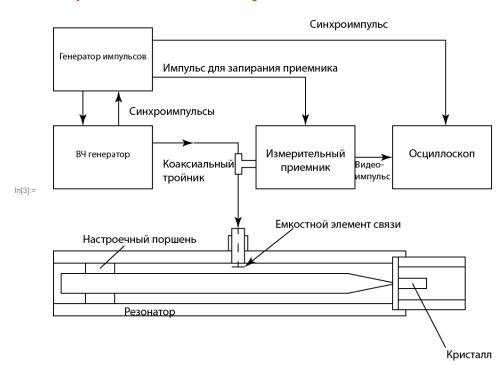
# Изучение особенностей возбуждения и распространения акустических волн СВЧ в твердых телах

## Выполнил: Нехаев Александр гр. 654

Цель работы: Снять частоту, зависимость коэффициента затухания амплитуды. Определить константы упругости 2 - го порядка.

#### Экспериментальная установка

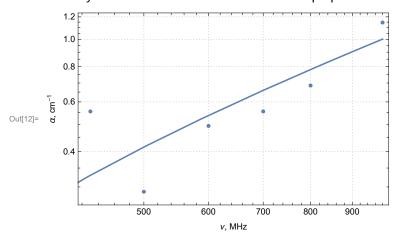


### Ход работы

**1.** Сняли частотную зависимость  $\alpha(v)$  в кристалле SiO<sub>2</sub>.

Out[9]//TableForm= **V**, МГц U1, B U2, B 430. MHz 1. V 2.1 V 0.555174/cm 500. MHz 3.4 V 5.V 0.288582/cm 600. MHz 0.493298/cm 5.8 V 700. MHz 2.V 4.2 V 0.555174/cm 800. MHz 4. V 0.685638/cm 1.6 V 980. MHz 0.8V 3.7 V 1.14597/cm

2. Полученная зависимость показана на графике.



Параметры образца:

ln[13]:= L = 2.9 cm; t = Quantity  $\left[\frac{54}{7}, \text{ "Seconds"}\right];$ 

**3.** Проведем расчет  $\Delta_{\text{диф}}$  на v=400 MHz по формуле

$$\Delta_{\text{диф}} = 20 * \text{Log} \left[ \frac{\lambda \, l}{\pi \, a^2} \right] * \frac{\text{Sin} \left[ \frac{\lambda \, l}{\pi \, a^2} * \frac{\pi}{3.83} \right]^4}{\left( \frac{\lambda \, l}{\pi \, a^2} * \frac{\pi}{3.83} \right)^4};$$

Радиус преобразователя приближенно равен:

ln[15]:= a = 0.05 cm; In[16]:= 1 = 2 L; $\lambda_3$  – длина волны УЗВ:  $ln[17]:= \lambda_3 = \frac{1/t}{400 \text{ MHz}};$ 

Тогда получаем:

Out[19]= -269.752

4. Определим скорость УЗВ в кристалле

In[20]:= 
$$\mathbf{V} = \frac{2 L}{t}$$

Out[20]= 0.751852 cm/s

Считая, что мы измерили скорость продольной волны, вычислили один из коэффициентов тензора модулей упругости:

Значение плотности  $\rho$  для  $SiO_2$ :

```
Out[21]= 2196. kg/m<sup>3</sup>

In[22]:= \mathbf{C}_{11} = \boldsymbol{\rho} * \mathbf{V}^2

Out[22]= 0.124136 kg/(m s<sup>2</sup>)
```

#### Вывод

Сняли частотную характеристику коэффициента затухания амплитуды УЗВ в кристалле  $SiO_2$ . Определили скорость распространения УЗВ в кристалле  $SiO_2$ . Определили константу упругости 2 – го порядка, оценили дифракционные потери в кристалле  $SiO_2$ .